

1 Lezione del 05-11-24

1.1 D-Latch trasparente

Introduciamo una nuova rete sequenziale dotata di due ingressi, d (data) e c (control), e un'uscita q . Il D-latch memorizza il bit in d quando c (**trasparenza**) vale 1. Quando c vale 0, invece, si dice che è in **conservazione**, ergo memorizza l'ultimo valore che d ha assunto quando c valeva 1.

La tabella di flusso di questa rete è la seguente, assunti in quest'ordine c e d :

	00	01	10	11	q
s_0	s_0	s_0	s_0	s_1	0
s_1	s_1	s_1	s_0	s_1	1

cioè quando si è in conservazione, qualsiasi valore di d viene ignorato e si memorizza il valore passato. Quando si è in trasparenza, invece, q si adegua a d .

Si può realizzare un D-latch attraverso un latch SR, con in ingresso una certa rete combinatoria. Quello che vogliamo fare è portare d e c in s e r , attraverso la tabella di verità:

c	d	s	r
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	0

Questo si sintetizza in $s = c \cdot d$ e $r = c \cdot \bar{d}$. Si ha che le porte AND che rappresentano le congiunzioni in questa rete combinatoria possono collassare con le porte AND che formavano la rete combinatoria del latch SR che permetteva preset e preclear.

1.1.1 Pilotaggio del D-Latch

Nel pilotaggio del D-latch, dobbiamo assicurarci che d sia costante a cavallo della transizione di c da 1 a 0, in quanto potremmo finire per memorizzare dati ignoti (l'ultima cosa che il D-latch ha "visto" prima del reset di c). I tempi per cui d deve essere costante, rispettivamente **prima** e **dopo** della transizione di c , si dicono T_{setup} e T_{hold} , e sono dati di progetto.

1.1.2 Trasparenza

Quando il D-latch è in **trasparenza**, il suo ingresso è direttamente connesso, in **senso logico** (ci sono comunque ritardi nella logica delle reti), all'uscita. Per questo motivo, se q e d sono collegati in **retroazione negativa** (un feedback loop negato), si ha che con $c = 1$ abbiamo oscillazioni incontrollate, e che con $c = 0$ in q (cioè lo stato interno) resta un valore casuale (l'ultimo rilevato durante le oscillazioni casuali prima che c sia transitato a 0).

Questo significa che il D-latch è una rete **trasparente**, cioè *la sua uscita cambia mentre la rete è sensibile alle variazioni di ingresso*. Questo significa che non possiamo memorizzare niente che sia funzione dell'uscita (saremmo nel caso della retroazione negativa di prima).

Poniamo di voler eseguire un'istruzione semplice come **INC** %AX. A livello hardware, questo significa connettere un registro (quindi una serie di D-latch) ad una rete combinatoria per l'incremento (probabilmente un half adder), e quindi l'uscita di questa rete di nuovo al D-latch. Quello che abbiamo essenzialmente creato è un ciclo di retroazione: il sistema devolgerà velocemente in uno stato di oscillazione incontrollata.

1.2 D flip-flop

Il **D flip-flop** è una rete sequenziale **non trasparente** che si pone di risolvere i problemi di trasparenza del D-latch. Quello che vedremo nel dettaglio è il **positive edge-triggered D flip-flop**, che è una rete che si comporta come segue, sulla base degli ingressi d (data) e p , e l'uscita q : quando p ha un fronte di salita, memorizza d , *attendi* un determinato istante temporale e adegua l'uscita.

Possiamo concettualizzare il D flip-flop come composto, alla base, da un D-latch. Mettiamo a c , invece dell'ingresso p , il **generatore di impulso** P^+ sul fronte di salita di p . In uscita a q , poi, abbiamo un buffer Δ , che introduce ritardo. La proprietà fondamentale che desideriamo è:

$$\Delta > P^+$$

Questo significa che q si adegua al valore campionato di d soltanto *dopo* che la rete ha smesso di essere sensibile a d . È questa proprietà a rendere il D flip-flop una rete non trasparente.

1.2.1 Pilotaggio del D flip-flop

Innanzitutto, a cavallo del fronte di salita di p l'ingresso d deve rimanere costante, ergo si hanno gli stessi $_{setup}$ e T_{hold} del D-latch. Inoltre, si ha il ritardo di adeguamento dell'uscita, che denominiamo T_{prop} (dall'inglese *propagation*). Qui la disuguaglianza di prima si traduce come:

$$T_{prop} > T_{hold}$$

Si che l'uscita di un D-FF non oscilla mai, a differenza di quella del D-Latch: l'adeguamento avviene in modo "secco", sul fronte di salita, e di lì in poi fino a reset e successivo set di p , l'uscita q è in conservazione e ignora il comportamento di d .

1.2.2 Sintesi Master-Slave di un D flip-flop

Storicamente, un D flip-flop è stato realizzato attraverso un montaggio master/slave, attraverso due D-latch in cascata (di cui uno master, e l'altro chiaramente slave). Si invia quindi l'ingresso p allo slave, e il suo negato al master, e si fa passare la linea d prima dal master, poi dalla sua uscita all'ingresso del slave, e poi al q del D flip-flop. Si ha che negli stati:

- $p = 0$: **master** e in *trasparenza*, **slave** in *conservazione*;
- $p = 1$: **master** in *conservazione*, **slave** in *trasparenza*.

Quando p è a 0, lo slave è in conservazione, quindi la rete memorizza. Nel frattempo il master è in trasparenza, quindi reagisce al valore in entrata di d . Quando p transisce a 1, lo slave passa in trasparenza, e quindi risponde a quello che esce dal master, che invece si trova in conservazione del valore che aveva un attimo prima della transizione. Il risultato è un comportamento effettivamente analogo a quello della struttura a generatore di impulso e buffer vista prima.

Si possono avere problemi nel funzionamento transitorio dei due D-latch: per questo si agisce elettronicamente, sviluppando questi per commutare c a valori di tensione diversi. In particolare, vogliamo che in transizione di p da 1 a 0 lo slave conservi il valore prima che il master passi a trasparenza, quindi che c dello slave commuti prima di c del master.

Nella pratica, infine, si ha che la sintesi reale di un D flip-flop è fatta a partire da un latch SR, prima del quale si dispone una rete sequenziale asincrona la cui sintesi è fuori dagli scopi del corso.

1.3 Memorie RAM statiche

Esistono due tipi principali di memoria:

- **S-RAM**, costituite da matrici di D latch;
- **D-RAM**, realizzate in modo diverso, che per adesso ignoreremo.

Una riga di D latch rappresenta quindi una **locazione di memoria**, che può essere **letta** o **scritta** con apposite operazioni, strettamente **non simultanee**.

Una SRAM è presenta gli ingressi e le uscite:

- **Ingressi di indirizzo:** in numero sufficiente per indirizzare tutte le celle di memoria. Ad esempio, con 2^{23} celle di 4 bit, 23 ingressi;
- **Ingressi/uscite di dati:** che andranno forchettati con porte **tri-state**;
- **Memory read** e **memory write**, segnali attivi bassi;
- **Select**, segnale attivo basso che fa da **enabler**, in modo simile a quanto avevamo visto nei decoder.

Il comportamento che vogliamo dalla SRAM è il seguente:

/s	/mr	/mw	Azione
1	-	-	Nulla
0	1	1	Nulla
0	0	1	Lettura in corso
1	1	0	Scrittura in corso

1.3.1 Temporizzazione delle RAM statiche

Facciamo innanzitutto la divisione lettura/scrittura:

- **Lettura:** per fare una lettura bisogna dare il comando (attivo basso) di memory read ($/mr$), e impostare l'indirizzo di lettura. Il comando di select ($/s$) arriva in ritardo, e a quel punto, quando sia $/s$ che $/mr$ sono in conduzione, i multiplexer vanno a regime e si può fare una lettura sull'uscita dei dati. Infine, quando $/mr$ torna a 1, i dati tornano ad alta impedenza, e l'indirizzo di lettura e la select possono assumere valori arbitrari.
- **Scrittura:** si ha che la scrittura è **distruttiva** (manda i D-latch in trasparenza). Bisogna quindi attendere che il select $/s$ e gli indirizzi siano stabili prima di abbassare $/mw$ per dare il comando di scrittura (l'opposto di quanto avevamo fatto in lettura,

qui vogliamo scrivere solo quando siamo sicuri di poterlo fare, ergo i multiplexer sono a regime). A questo punto, abbiamo che quando \overline{mw} torna alto dobbiamo assicurarci che i dati in scrittura siano fermi, in quanto i multiplexer riportano gli ingressi di controllo dei D-latch a 0 e l'indirizzo di lettura e la select possono, nuovamente, assumere valori arbitrari.

1.3.2 Montaggio di banchi di memoria

Vediamo come combinare più banchi di memoria per aumentare lo spazio di memoria indirizzabile.

- **Montaggio in parallelo:** prendiamo in considerazione due banchi di memoria da $8M \times 4$ bit, e vediamo come collegarli per formare un singolo banco di memoria da $8M \times 8$ bit, quindi raddoppiando la dimensione delle locazioni.
 - Per quanto riguarda gli **indirizzi di lettura**, basta inviare l'indirizzo ad entrambi i banchi, da cui preleveremo la parte *alta* e *bassa* della locazione;
 - Per quanto riguarda gli **ingressi/uscite di dati**, avremo che la combinazione delle linee sui due banchi, da 4 bit ciascuna, formano un singolo byte da 8 bit, ergo la locazione di memoria completa.
- **Montaggio in serie:** prendiamo in considerazione due banchi di memoria da $8M \times 8$ bit, e vediamo come collegarli per formare un singolo banco di memoria da $16M \times 8$ bit, quindi raddoppiando il numero di locazioni.
 - Per quanto riguarda gli **indirizzi di lettura**, discrimina dal MSB dell'indirizzo se selezionare dal primo o dal secondo banco, che faranno quindi da parte *alta* e *bassa* dello spazio di memoria indirizzabile. Facciamo questo attraverso l'ingresso di select $/s$, che useremo per determinare altri due segnali di select $/s1$ e s_h (*select low* e *select high*), che a loro volta ci permettono di discriminare sulla base del MSD quale banco andiamo a selezionare (effettivamente rendere attivo);
 - Per quanto riguarda gli **ingressi/uscite di dati**, avremo che il banco attivo in un dato momento determina completamente le uscite. Potremmo pensare di dover inserire porte tri-state in uscita ai singoli banchi di memoria sulla linea di ingresso/uscita, ma questo non è necessario: le $s1$ e s_h sono mutualmente esclusive, e quindi non si verificherà mai il caso in cui le linee di uscita di entrambi i banchi sono in conduzione contemporaneamente.